

Standard Rectifier

$$V_{RRM} = 1600 \text{ V}$$

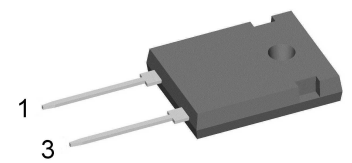
$$I_{FAV} = 45 \text{ A}$$

$$V_F = 1.23 \text{ V}$$

Single Diode

Part number

DSI45-16A



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

Package: TO-247

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1700	V	
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1600	V	
I_R	reverse current	$V_R = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		40	μA	
		$V_R = 1600\text{ V}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		1.5	mA	
V_F	forward voltage drop	$I_F = 45\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.26	V	
		$I_F = 90\text{ A}$			1.57	V	
		$I_F = 45\text{ A}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		1.23	V	
		$I_F = 90\text{ A}$			1.66	V	
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 130^{\circ}C$ 180° sine	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		45	A	
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		0.81	V	
r_F	slope resistance				9.1	m Ω	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.55	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.3		K/W	
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		270	W	
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		480	A	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		520	A	
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		410	A	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		440	A	
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		1.15	kA ² s	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		1.13	kA ² s	
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		840	A ² s	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		805	A ² s	
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		18	pF	



Package TO-247			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		175	°C
T_{op}	operation temperature		-40		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking



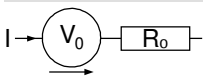
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSI45-16A	DSI45-16A	Tube	30	471917

Similar Part	Package	Voltage class
DSI45-16AR	ISOPLUS247 (2)	1600
DSI45-12A	TO-247AD (2)	1200
DSI45-08A	TO-247AD (2)	800

Equivalent Circuits for Simulation

** on die level*

$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$



Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.81	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	6.5	mΩ



Outlines TO-247



Sym.	Inches		Millimeter	
	min.	max.	min.	max.
A	0.185	0.209	4.70	5.30
A1	0.087	0.102	2.21	2.59
A2	0.059	0.098	1.50	2.49
D	0.819	0.845	20.79	21.45
E	0.610	0.640	15.48	16.24
E2	0.170	0.216	4.31	5.48
e	0.430 BSC		10.92 BSC	
L	0.780	0.800	19.80	20.30
L1	-	0.177	-	4.49
Ø P	0.140	0.144	3.55	3.65
Q	0.212	0.244	5.38	6.19
S	0.242 BSC		6.14 BSC	
b	0.039	0.055	0.99	1.40
b2	0.065	0.094	1.65	2.39
b4	0.102	0.135	2.59	3.43
c	0.015	0.035	0.38	0.89
D1	0.515	-	13.07	-
D2	0.020	0.053	0.51	1.35
E1	0.530	-	13.45	-
Ø P1	-	0.29	-	7.39





Rectifier

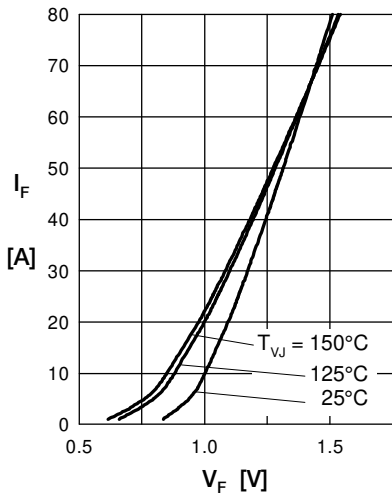


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

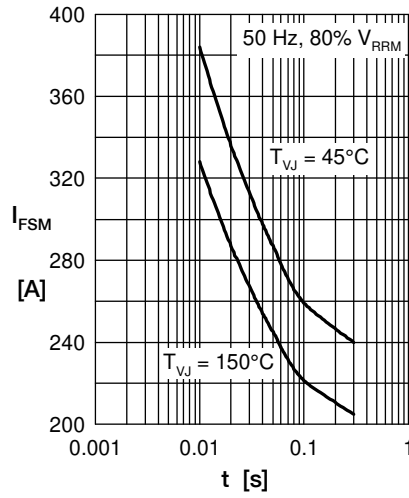


Fig. 2 Surge overload current

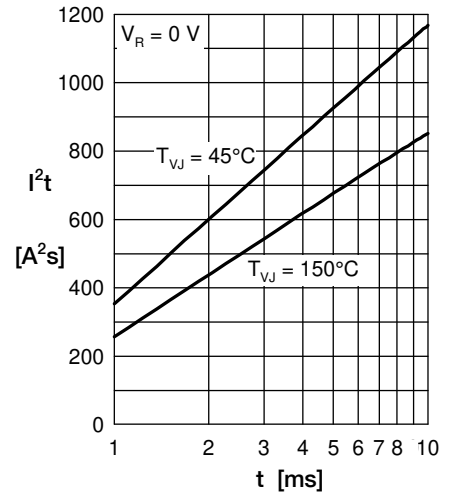


Fig. 3 I^2t versus time per diode

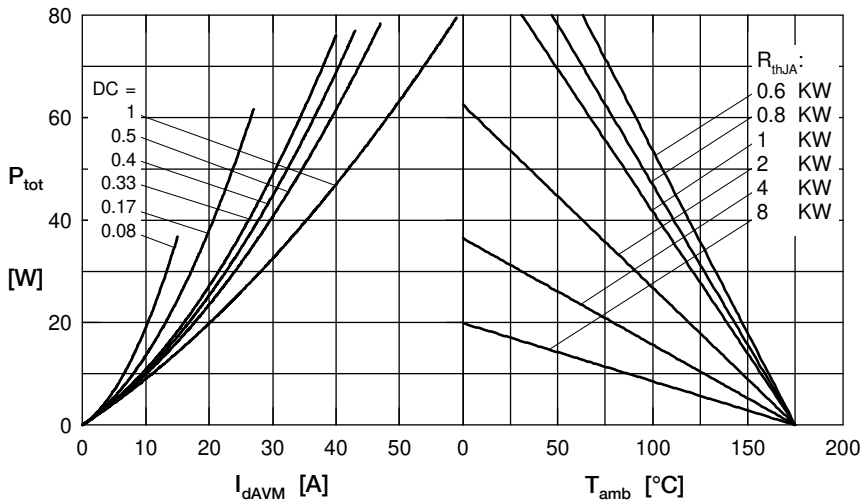


Fig. 4 Power dissipation vs. direct output current & ambient temperature

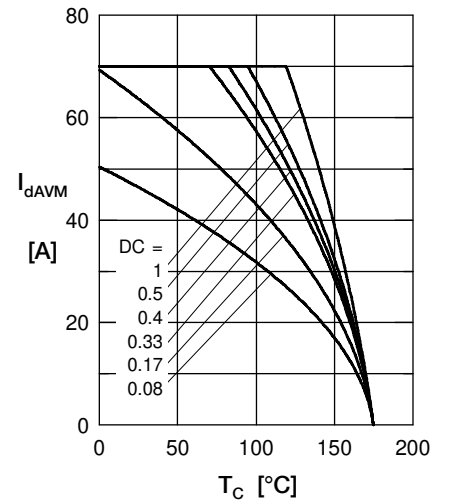


Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature

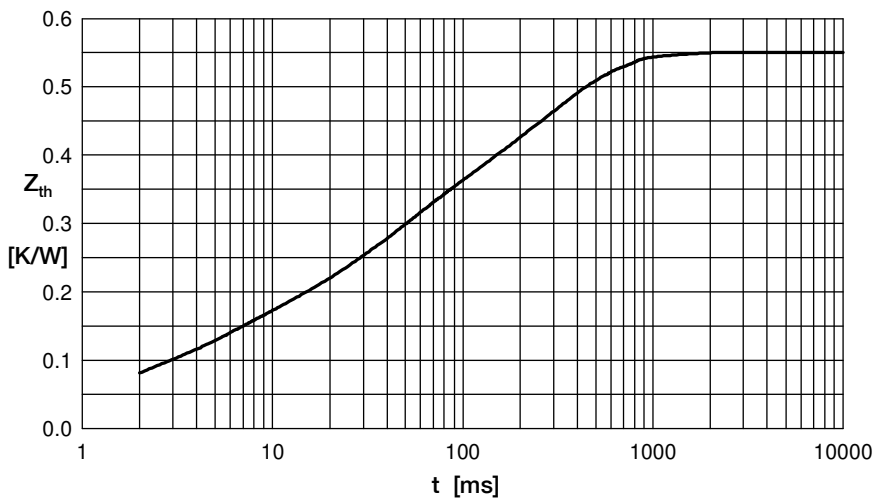


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case

i	R _i	t _i
1	0.033	0.0006
2	0.095	0.0039
3	0.164	0.033
4	0.258	0.272



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.